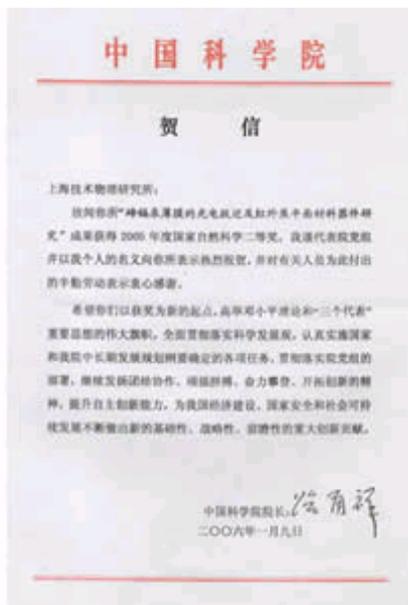




我所“碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材料器件研究”荣获2005年国家自然科学二等奖

来源：技术物理研究所网站 作者：任远



2006年1月9日，全国科学技术大会在人民大会堂隆重召开，我所“碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材料器件研究”荣获国家自然科学二等奖。

碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材料器件研究是红外光电子信息学科的科学前沿，主要研究碲镉汞半导体中的带间光吸收跃迁效应以及带内、杂质、声子光跃迁、载流子输运和碲镉汞红外焦平面材料器件研制的基本物理问题。研究结果不仅发展了窄禁带半导体物理学，而且可应用于碲镉汞材料设计、生长和表征以及器件研制，促进了我国xxx×1元、xxxx×1元的碲镉汞线列焦平面以及xx×xx元、xxx×xxx元碲镉汞焦平面阵列器件的研制成功，使我国碲镉汞焦平面阵列器件的研制水平进入先进国家序列，为满足国家这方面的重大需求做出了重要贡献。

该项科技成果是长期积累的硕果，是全所职工的骄傲，让我们继续发扬“求真、务实、合作、守信”的所风精神，不断做出新的基础性、战略性、前瞻性的重大创新贡献。

图片报道



二室春节前后开展基金



扎实推进业务培训 我



市科教党委领导来我所



我做一次文明交通志愿



协力创新求进步——我

相关信息：碲镉汞

- [： 我所“碲镉汞薄膜的光电跃迁及红外焦平面材料器件研究”荣获2005年国家…](#) (1.23)

Copyright 2003 - 2005 All Rights Reserved 上海技术物理研究所 版权所有 Email: webmaster

主办：中国科学院上海技术物理研究所 技术支持：计算机信息中心 备案序号：[沪ICP备05005482号](#)